

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成24年2月16日(2012.2.16)

【公開番号】特開2010-242187(P2010-242187A)

【公開日】平成22年10月28日(2010.10.28)

【年通号数】公開・登録公報2010-043

【出願番号】特願2009-93549(P2009-93549)

【国際特許分類】

C 2 3 C	16/40	(2006.01)
H 0 1 L	21/285	(2006.01)
H 0 1 L	21/28	(2006.01)
H 0 1 L	23/52	(2006.01)
H 0 1 L	21/3205	(2006.01)
H 0 1 L	21/314	(2006.01)

【F I】

C 2 3 C	16/40	
H 0 1 L	21/285	C
H 0 1 L	21/28	3 0 1 R
H 0 1 L	21/88	M
H 0 1 L	21/314	A

【手続補正書】

【提出日】平成23年12月1日(2011.12.1)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項4】

前記酸化マンガン膜が、MnOの層、MnOとSiO_xとの混合層、Mn(OH)₂とMnOとの混合層、及びMn(OH)₂の層の少なくともいずれか一つを含むことを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の酸化マンガン膜の形成方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項10

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項10】

前記酸化マンガン膜の成膜法が、熱CVD法であることを特徴とする請求項7から請求項9のいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法。